



Features:

Volle Sperrfähigkeit bei 125° mit 50 Hz

Full blocking capability at 125°C with 50 Hz

Hoher Stoßstrom und niedriger Wärme-
widerstand durch NTV-Verbindung
zwischen Silizium und Mo-Trägerscheibe.

High surge currents and low thermal resistance
by using low temperature-connection NTV between
silicon wafer and molybdenum.

Elektroaktive Passivierung durch a - C:H

Electroactive passivation by a - C:H

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts - und Rückwärts - Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltage	f = 50 Hz	V _{DRM} , V _{RRM}	t _{vj min} = -40°C 6000 6500 7000	t _{vj min} = 0°C 6200 6700 7200	V V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMS forward current		I _{TRMSM}		3500	A
Dauergrenzstrom mean forward current	t _c = 85°C, f = 50Hz t _c = 60°C, f = 50Hz	I _{TAVM}		1650 2220	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge forward current	t _{vj} = 25°C, t _p = 10ms, V _R = 0 t _{vj} = t _{vj max} , t _p = 10ms, V _R = 0	I _{TSM}		50 48	kA kA
Grenzlastintegral I ² t-value	t _{vj} = 25°C, t _p = 10ms t _{vj} = t _{vj max} , t _p = 10ms	I ² t		12,5 · 10 ⁶ 11,5 · 10 ⁶	A ² s A ² s
Gehäusegrenzstrom case non-rupture current	Sinushalbwellen t _p = 10 ms sine half wave t _p = 10 ms			75	kA
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 f = 50Hz, v _D = 0,67 V _{DRM} i _{GM} = 3A, di _c /dt = 6A/µs	(di/dt) _{cr}		300	A/µs
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	t _{vj} = t _{vj max} , v _D = 0,67 V _{DRM} 5. Kennbuchstabe / 5 th letter H	(dv/dt) _{cr}		2000	V/µs



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, i_T = 3\text{kA}$	V_T	typ 2,45	Max 2,65	V
Schleusenspannung / threshold voltage Ersatzwiderstand / slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	$V_{(TO)}$ r_T	typ 1,2 0,425	max 1,22 0,49	V mΩ
Durchlaßrechenkennlinien On - state characteristics for calculation $V_T = A + B \cdot i_T + C \cdot \ln(i_T + 1) + D \cdot \sqrt{i_T}$ 500 A ≤ i_T ≤ 5000 A	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	A B C D	typ 0,774 0,000186 -0,0199 0,0235	max 0,623 0,000271 0,0346 0,0173	
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\text{V}$	I_{GT}		350	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\text{V}$	V_{GT}		2,5	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 6\text{V}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	I_{GD}		20 10	mA mA
nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	V_{GD}		0,4	V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 12\text{V}, R_A = 4,7\Omega$	I_H		350	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 12\text{V}, R_{GK} \geq 10\Omega$ $i_{GM} = 3\text{A}, di_G/dt = 6\text{A}/\mu\text{s}, t_g = 20\mu\text{s}$	I_L		4	A
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents	$T_{vj} = T_{vj\ max}$ $V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$	i_D, i_R		200	mA
Zündverzögerung gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $t_{vj} = 25^\circ\text{C},$ $i_{GM} = 3\text{A}, di_G/dt = 6\text{A}/\mu\text{s}$	t_{gd}		2	μs
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\ max}, I_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100\text{V}, V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dV_D/dt = 20\text{V}/\mu\text{s}, -di_T/dt = 10\text{A}/\mu\text{s}$ 4. Kennbuchstabe / 4 th letter O	t_q	typ	650	μs
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$T_{vj} = T_{vj\ max}$ $I_{TM} = 2\text{kA}, di/dt = 10\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = 0,5 V_{RRM}, V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$	Q_r		12	mAs
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$T_{vj} = T_{vj\ max}$ $I_{TM} = 2\text{kA}, di/dt = 10\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = 0,5 V_{RRM}, V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$	I_{RM}		280	A

Netz Thyristor
Phase Control Thyristor

T 1651N 60...70TOH

N



Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	beidseitig / two-sided, $\theta = 180^\circ \sin$	R_{thJC}	0,0075	°C/W
	beidseitig / two-sided, DC		0,007	°C/W
	Anode / anode DC		0,011	°C/W
	Kathode / cathode DC		0,019	°C/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	beidseitig / two-sided	R_{thCK}	0,002	°C/W
	einseitig / single-sided		0,004	°C/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature		$T_{vj \max}$	125	°C
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c \text{ op}}$	-40...+125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40...+150	°C

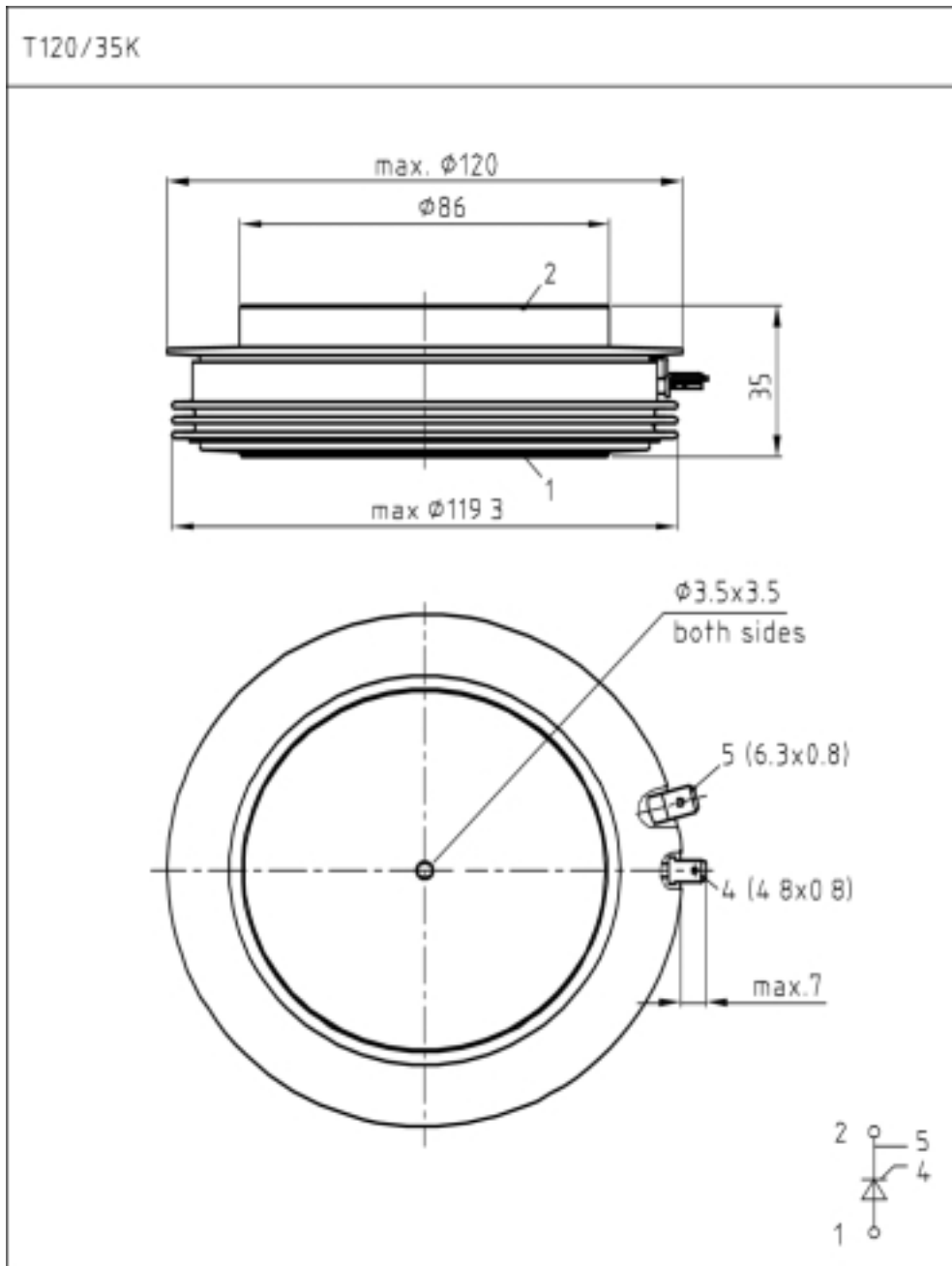
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			Seite 4	
Si-Element mit Druckkontakt, Amplifying-Gate Si-pellet with pressure contact, amplifying gate			88TEN70	
Anpreßkraft clampig force		F	45..65	KN
Gewicht weight		G	typ 1850	g
Kriechstrecke creepage distance			33	mm
Feuchteklasse humidity classification	DIN 40040		C	
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50Hz		50	m/s ²

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.
This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.



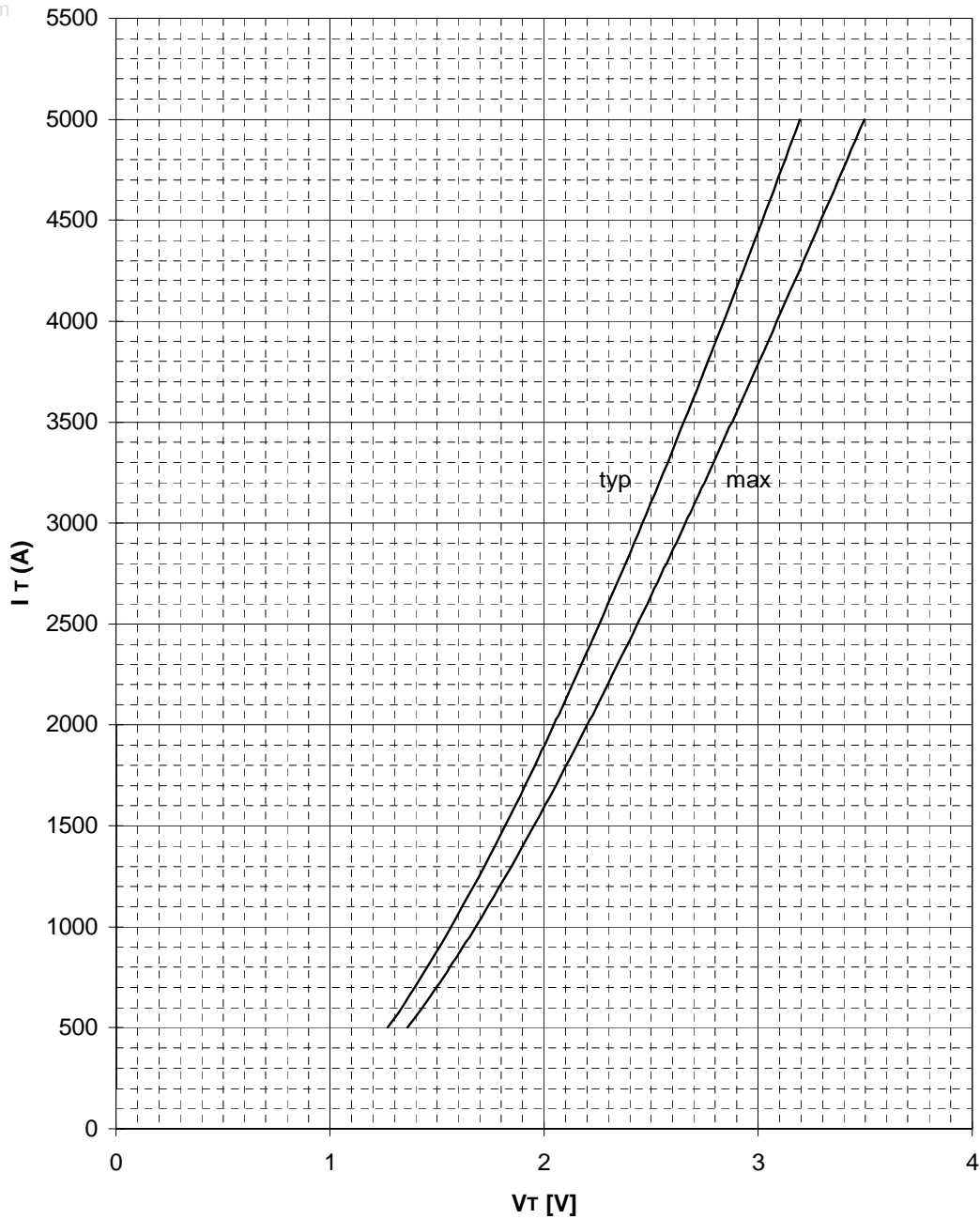
Maßbild / Outline





Durchlaßkennlinie $i_T = f(v_T)$
Limiting and typical on-state characteristic

— $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$

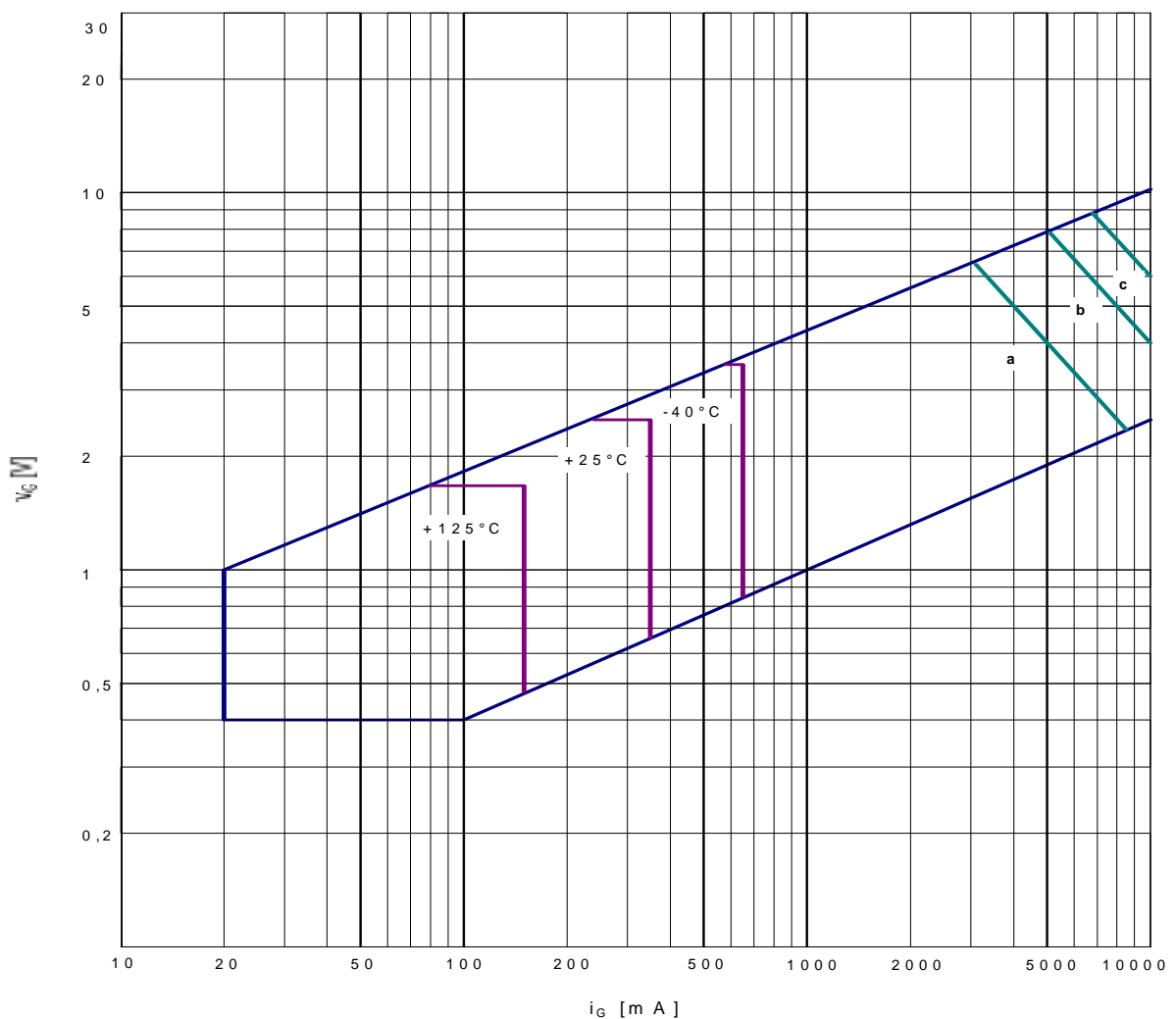




Steuerkreischarakteristik mit Zündbereichen
Gate characteristic with triggering areas

$V_G = f(i_G), V_D = 6V$

Parameter	a	b	c
Steuerimpulsdauer / trigger pulse duration t_G (ms)	10	1	0.5
Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung Max. rated peak power dissipation P_{GM} (W)	20	40	60



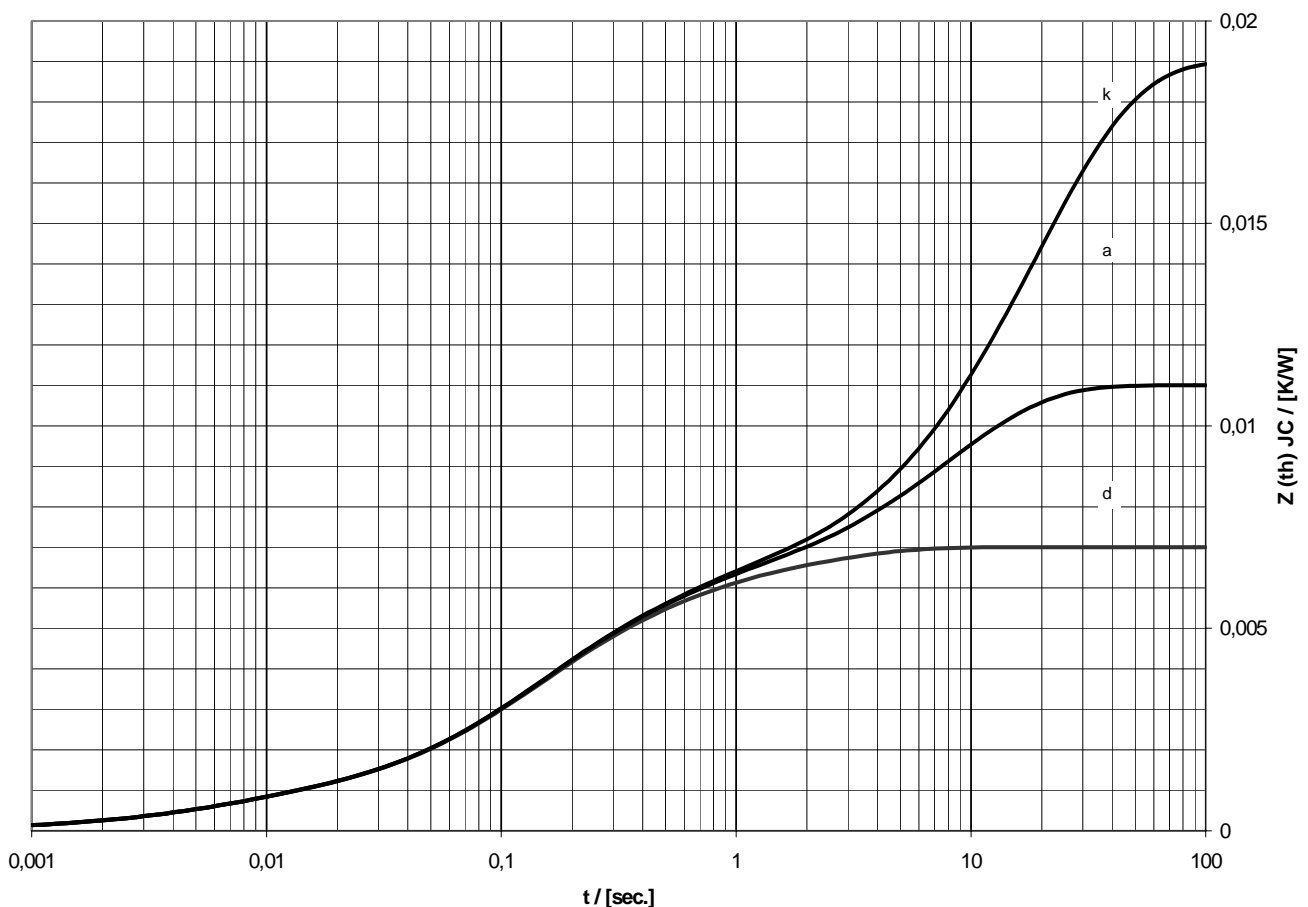


Transienter innerer Wärmewiderstand
Transient thermal impedance $Z_{(th)JC} = f(t)$

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \cdot (1 - e^{-t/\tau_n})$$

www.DataSheet4U.com

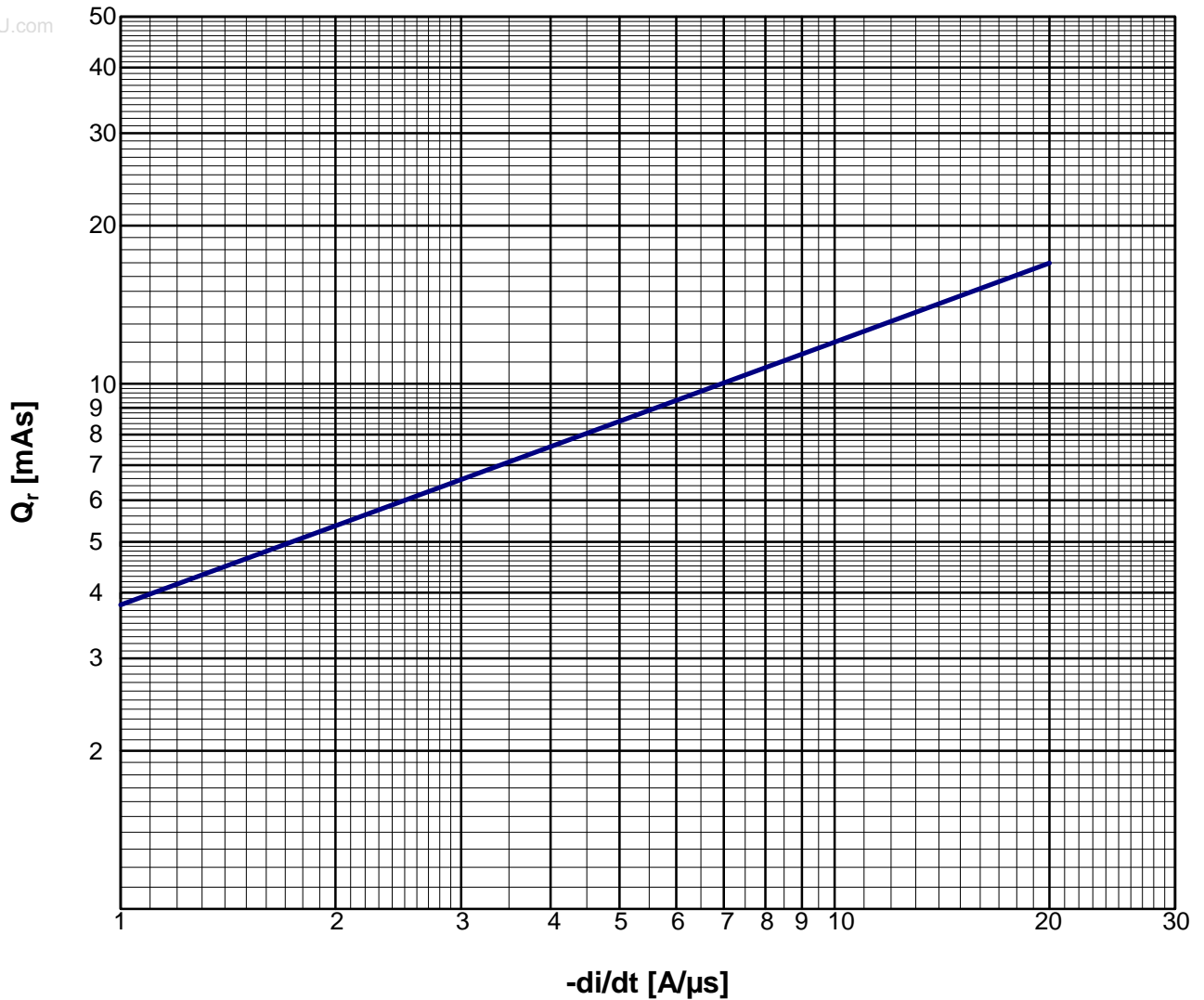
	doppelseitige Kühlung		anodenseitige Kühlung		kathodenseitige Kühlung	
	r [K/W]	[s]	r [K/W]	[s]	r [K/W]	[s]
1	0,0012	1,95	0,0051	8	0,0131	19
2	0,0021	0,38	0,0022	0,39	0,0022	0,38
3	0,0007	0,14	0,0007	0,14	0,0007	0,14
4	0,0024	0,103	0,0024	0,103	0,0024	0,103
5	0,0006	0,005	0,0006	0,005	0,0006	0,005
	0,007	-	0,011	-	0,019	-





Sperrverzögerungsladung $Q_r = f(-di/dt)$
recovered charge

$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}, I_{TM} = 2000\text{A}, v_R = 0,5 V_{RRM}, v_{RM} = 0,8 V_{RRM}$





Rückstromspitze / reverse recovery current
(typische Abhängigkeit / typical dependence)

$$I_{RM} = f(-di/dt)$$

$T_{vj} = 125^{\circ}C, I_{TM} = 2000A, v_R = 0,5 \cdot V_{RRM}, v_{RM} = 0,8 \cdot V_{RRM}$

